



# Desenvolvimento de uma nova metodologia sintética para obtenção de um compósito de Bi/β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> para aplicação em baterias aquosas

Luiz P. F. Santos\*<sup>1</sup>, Paulo F. R. Ortega<sup>1</sup>, Garbas A. dos Santos Junior<sup>1</sup> Departamento de Química, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa \*e-mail: luiz.p.santos@ufv.br; garbas.junior@ufv.br

#### RESUMO

A crescente demanda por materiais avançados e de alto desempenho para sistemas de armazenamento de energia eletroquímica, como baterias e supercapacitores, tem impulsionado a busca por novos materiais anódicos. Nesse contexto, o óxido de bismuto (Bi $_2O_3$ ) destaca-se como um candidato promissor devido à sua alta capacidade teórica, ampla disponibilidade e baixo custo. No entanto, seu uso é limitado por fatores como baixa condutividade eletrônica e estabilidade cíclica insatisfatória. O presente trabalho apresenta a síntese de um compósito Bi/ $\beta$ -Bi $_2O_3$  por meio de uma rota solvotérmica simples, seguida de tratamento térmico, favorecendo a redução parcial do Bi $_3$  e a evolução de oxigênio molecular. Essa abordagem resultou na formação de uma estrutura bifásica contendo bismuto metálico e  $\beta$ -Bi $_2O_3$ , conforme confirmado por difração de raios X, indicando também a introdução de defeitos estruturais, como vacâncias de oxigênio. As avaliações eletroquímicas realizadas em solução de KOH 6 mol·L $_1$  demonstraram o desempenho superior do compósito em relação ao  $\beta$ -Bi $_2O_3$  puro. A uma densidade de corrente de 0,5 A·g $_1$ , o Bi/ $\beta$ -Bi $_2O_3$  apresentou uma capacidade específica de 705,4 C·g $_1$ , um aumento de 26% em comparação aos 559,9 C·g $_1$  do óxido não modificado. Além disso, o compósito exibiu excelente comportamento em altas taxas de corrente, retendo 32% da capacidade inicial a 10 A·g $_1$ , em contraste com apenas 12,7% para o  $\beta$ -Bi $_2O_3$  puro. Os resultados obtidos comprovam que a engenharia de defeitos — especialmente a introdução de vacâncias de oxigênio — é uma estratégia eficaz para melhorar a condutividade e a capacidade eletroquímica do Bi $_2O_3$ . A metodologia proposta destaca-se por sua simplicidade, rapidez e viabilidade econômica, consolidando-se como uma alternativa promissora para o desenvolvimento de eletrodos de alto desempenho para dispositivos de armazenamento de energia.

Palavras-chave: Óxido de Bismuto, Baterias, Compósitos, Energia

#### Introdução

Atualmente, há uma demanda crescente por materiais de alto desempenho voltados para aplicações em armazenamento de energia eletroquímica. Esses sistemas, como baterias e supercapacitores, exigem materiais capazes de conciliar alta densidade de energia e elevada densidade de potência. Neste contexto, o óxido de bismuto (Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) destaca-se como um material promissor devido à sua elevada capacidade teórica, baixo custo, facilidade de síntese e potencial de aplicação como eletrodo negativo. Entretanto, a utilização do Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> é limitada por sua baixa condutividade eletrônica e estabilidade cíclica. Para superar essas limitações, diversas estratégias vêm sendo exploradas, incluindo a dopagem, a formação de compósitos com materiais carbonáceos e a introdução de defeitos estruturais, como vacâncias de oxigênio. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma nova metodologia sintética baseada na redução térmica do Bi, visando a introdução controlada de defeitos estruturais no material, com o intuito de aprimorar suas propriedades para o armazenamento de energia.

## **Experimental**

Método de síntese

Neste estudo, foi explorada a síntese solvotermal do  $\beta$ –Bi $_2$ O $_3$ , seguida de tratamento térmico em atmosfera de nitrogênio, a partir do precursor Bi(NO $_3$ ) $_3$ .5H $_2$ O, dissolvidos em etilenoglicol e álcool etílico. Na sequência, a mistura foi transferida para uma autoclave de teflon e aquecida a 160 °C por 4 horas. O precursor, Bi(OH) $_3$ , foi lavado com água destilada e seco em estufa a 60°C por 12 horas. O Bi(OH) $_3$  passou por tratamento térmico a 400°C por 1 hora em atmosfera de N $_2$ . A obtenção do  $\beta$ –Bi $_2$ O $_3$  ocorreu com o resfriamento do material à temperatura ambiente em atmosfera rica em O2, enquanto o compósito, Bi/  $\beta$ –Bi $_2$ O $_3$  foi obtido com o resfriamento em atmosfera de N2.

Avaliação estrutural e desempenho eletroquímico

Para a avaliação das características estruturais e morfológicas dos materiais, foram empregadas as técnicas de difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia no infravermelho (FT-IR). O desempenho eletroquímico dos materiais foi analisado por meio das técnicas de voltametria cíclica (VC) e testes de carga e descarga galvanostática

(CD). Os eletrodos foram preparados a partir da mistura do material ativo, negro de carbono (carbon black) e PVDF, nas proporções de 80%, 15% e 5%, respectivamente. As medidas eletroquímicas foram realizadas em células de três eletrodos, utilizando o eletrodo com o material ativo como eletrodo de trabalho, um eletrodo de grafite como contra eletrodo e Ag/AgCl 3.5M como eletrodo de referência. Como eletrólito, utilizou-se uma solução aquosa de KOH 6 mol·L<sup>-1</sup>.

#### Resultados e Discussão

Caracterização estrutural e morfológica.

A síntese do compósito se baseou nas equações (1) e (2)

$$Bi(OH)_3 \to Bi_2O_3 + 3H_2O \tag{1}$$

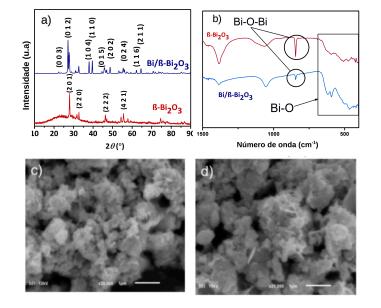
$$Bi_2O_3 \rightleftharpoons 2Bi + \frac{3}{2}O_2 \tag{2}$$

A primeira etapa, equação 1, se baseia na decomposição de  $Bi(OH)_3$  em  $Bi_2O_3$ , na fase metaestável beta,  $\beta$ – $Bi_2O_3$ , obtida pelo tratamento térmico em condições térmicas brandas em atmosfera não oxidante. Já, a formação de defeitos de oxigênio foi promovida pelo controle da atmosfera durante o resfriamento, baseado no equilíbrio químico, equação 2. Em atmosferas ricas em  $O_2$ , o óxido de bismuto é favorecido, entretanto, ao manter o óxido na atmosfera de  $N_2$ , até seu resfriamento, o equilíbrio químico se desloca para a redução de bismuto 3+ a bismuto metálico e evolução de  $O_2$ .

A constatação da formação das fases esperadas foi feita a partir dos padrões de difração de raios X (Figura 1a). Os difratogramas revelam a formação de bismuto metálico (romboédrico) com picos em 27,16° (0 1 2), 37,95° (1 0 4) e 39,61° (1 1 0), além de picos associados ao  $\beta$ -Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (tetragonal).

No FTIR (Figura 1b), os materiais apresentaram diferenças cruciais que corroboram para a identificação das diferentes fases, em ambos os óxidos. Nota-se uma semelhança entre as bandas em 400 a 700 cm<sup>-1</sup> que representa as vibrações dos átomos de Bi-O do sítio octaédrico, correspondente ao BiO<sub>6</sub>, no Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Já, o estiramento em 840 cm<sup>-1</sup>, se refere às vibrações das ligações de Bi-O-Bi, também referente ao  $\beta$ -Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Entretanto, essa última aparece em menor intensidade para o compósito, representado na cor vermelha, tem menor intensidade, Bi/ $\beta$ -Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, em relação ao  $\beta$ -Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, podendo ser explicada pelas vacâncias de oxigênio na do compósito. Já as figuras 1c e 1d mostram que os materiais apresentaram a mesma morfologia.

**Figura 1:** (a) Difratogramas de raios-X e (b) FTIR para β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>e Bi/β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Imagens de Microscopia eletrônica de varredura para (c) β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> e (d) Bi/β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>



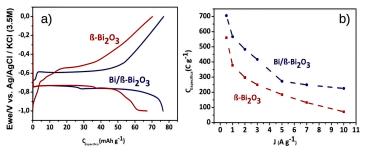
#### Caraterização eletroquímica

As curvas de carga/descarga galvanostática para  $\beta$ -Bi $_2$ O $_3$  e Bi/ $\beta$ -Bi $_2$ O $_3$  (0.5 A g $^{-1}$ ) são apresentadas na Figura 2a. mostram um platô na carga e um platô na descarga. A reação de descarga, processo de redução é apresentado na equação 3.

$$Bi_2O_3 + 6e^- + 6OH^- \rightarrow 2Bi$$
 (Equação 3)

Nessa densidade de corrente nota-se um desempenho eletroquímico superior do  $Bi/\beta-Bi_2O_3$  em relação ao  $\beta-Bi_2O_3$ , no qual, as capacidades específicas atingidas foram de 559,9 C  $g^{-1}$  para o  $\beta-Bi_2O_3$  e 705,4 C  $g^{-1}$  para o compósito, uma melhora de 26%.

**Figura 2:** (a) Curvas de carga/descarga galvanostática e (b) capacidade específica em função da densidade de corrente para β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>e Bi/β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>



Por fim, os materiais foram submetidos a diferentes densidades de corrente, figura 2b. em todas as densidades foi possível comprovar o melhor desempenho para o compósito em relação ao óxido puro. Os valores atingidos de capacidade específica foram para o β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 559,90 (0,5 A g<sup>-1</sup>), 377,63 (1,0 A g<sup>-1</sup>), 297,58 (2,0 A g<sup>-1</sup>), 249,67 (3,0 A g<sup>-1</sup>), 184,86 (5,0 A g<sup>-1</sup>) , 132,41 (7,0 A g<sup>-1</sup>) e 71,16 (10,0 A g<sup>-1</sup>). Já, para o Bi/β-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 705,43 (0,5 A g<sup>-1</sup>), 566,94 (1,0 A g<sup>-1</sup>), 483,11 (2,0 A g<sup>-1</sup>), 416,53 (3,0 A g<sup>-1</sup>), 272,50 (5,0 A g<sup>-1</sup>) , 249,33 (7,0 A g<sup>-1</sup>) e 225,17 (10,0 A g<sup>-1</sup>).

Os resultados comprovam que a simples modificação realizada na obtenção do óxido de bismuto levou a formação do compósito com vacâncias de oxigênio que contribuíram para um melhor desempenho eletroquímico do material.

#### Conclusões

O presente trabalho apresentou a síntese do compósito  $\mathrm{Bi}/\beta\mathrm{-Bi_2O_3}$  a partir de um novo método, baseado em uma metodologia simples, com o favorecimento da redução parcial do  $\mathrm{Bi^{3^+}}$  e evolução de oxigênio molecular.

O compósito,  $Bi/\beta-Bi_2O_3$  apresentou um desempenho superior em relação ao óxido puro no intervalo de densidade de corrente estudado  $0.5-10~A~g^{-1}$ . A  $0.5~A~g^{-1}$  O compósito apresentou uma capacidade específica de  $705.4~C~g^{-1}$ , um aumento de 26% em relação ao  $\beta-Bi_2O_3$  ( $559.9~C~g^{-1}$ ). Confirmando que a estratégia de vacâncias de oxigênio pode ser estudada como aprimoramento no desempenho eletroquímico do óxido de bismuto. Além disso, a nova metodologia sintética desenvolvida e apresentada, se mostrou eficaz para a formação de uma estrutura de  $Bi_2O_3$ , de fase metaestável, com vacâncias de oxigênio, sendo um processo simples, rápido e sem a adição de custos excessivos ao processo de obtenção do material.

#### Agradecimentos

FAPEMIG (APQ-01313-24 e APQ-00469-22) e CNPq (406535/2022-1.

### Referências

- 1. SUN, Ningqiang et al. Eletrochem Acta v. 409, 2022
- 2. FUJITA, Ikuro et al. Scrip Mat, v 187, p.366-370, **2020**.